Облікова картка ДіР

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0305U001675

Державний реєстраційний номер: 0104U003728

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 30-03-2005

II. Етап виконання ДіР

Номер етапу: 1

Назва етапу: Дослідження впливу зовнішніх чинників на фізичні та експлуатаційні характеристики монокристалічних, аморфних, нано- та квазікристалічних систем

Початок етапу: 01.2004

Закінчення етапу: 12.2004

Вид звітного документа: Без звіту

III. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, кафедра загальної і молекулярної генетики

Код за ЄДРПОУ: 02070944

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління: Кабінет міністрів

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 2525882

IV. Відомості про співвиконавців ДіР

V. Відомості про замовника ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Код за ЄДРПОУ: 02070944

Місцезнаходження: вул. Володимирська, 60, м. Київ, Київська обл., 01033, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 0442393141

VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР

Підстава для проведення ДіР: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук (головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)

Напрям фінансування:

Джерела фінансування

VII. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Фізико-хімічні основи одержання перспективних металічних та напівпровідникових матеріалів та дослідження їх властивостей

Назва роботи англійською:

Physical and chemical backgrounds for the preparing of the prospective metallic ans semiconductive materials and investigation of their properties

Реферат українською:

Запропоновані метод діагностики домішкових комплексів та концепція лазерного та ультразвукового управління процесами рухливості дислокацій в кристалах кремнію. Розроблені покриття та способи їх напилення, рекомендовані для практичного застосування. Встановлено, що для деяких чистих металів і БКМ термо-ЕРС змінюється з ростом деформації в 2-3 етапи

Реферат англійською:

The method for impurity complexes diagnostics in silicon has been proposed.The conception of laser and ultrasonic governing of the dislocation mobility has been developed. The coatings prospective for industrial application and the methods of their deposition have been worked out. Thermoelectric power of a series of pure metals and multilayered composites was shown to vary upon deformation in 2-3 stages. The diffusivity processes in these materials enhance upon the layered thickness decrease.

Індекс УДК: 548.571;548.4, 548;548.4;537.511.44;539.213:538

Коди тематичних рубрик: 29.19.11

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Макара Володимир Арсенійович

Науковий ступінь:

Вчене звання:

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)

IX. Бібліографічний опис

Фізико-хімічні основи одержання перспективних металічних та напівпровідникових матеріалів та дослідження їх властивостей54905490

X. Заключні відомості

Керівник юридичної особи Гондюл Валерій Петрович

Перелік осіб-виконавців

Відповідальний за підготовку облікових документів

Телефон

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності

